

شبیه سازی کامپیوتری و تحلیل استفاده از الگوهای جدید آلایشی در ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی جهت کاهش جریان خاموشی و ولتاژ آستانه

سجاد جعفری نمک اورانی*,210,

1398-07-07

در این پژوهش ابتدا JLTFT را در محیط سیلواکو شبیه سازی می کنیم با توجه به اهمیت جریان خاموشی و ولتاژ آستانه در این ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با استفاده از الگوهای جدید آلایشی مقدار جریان خاموشی و ولتاژ آستانه را کاهش میدهیم. مهندسی افزاره تاثیر مستقیمی بر روی جریان نشتی ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی دارد. با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری سعی داریم بهترین نتیجه را در کاهش جریان خاموشی و ولتاژ آستانه ارائه کنیم. ما در این پژوهش اثر تکنیک های مهندسی آلایش و تنوع مواد بر جریان خاموشی و ولتاژ آستانه JLTFT را شبیه سازی و تحلیل میکنیم.

کلمات کلیدی : ترانزیستور اثر میدان غیر پیوندی ، جریان خاموشی ، ولتاژ آستانه

[Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database](#)

[دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها](#)